課題番号 :F-18-NM-0039

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) :プラズマ援用 AD 膜の評価

Program Title(English) : Evaluation of plasma assisted AD film

利用者名(日本語) : <u>和田琢真</u> Username(English) : <u>T. Wada</u>

所属名(日本語) :TOTO 株式会社 Affiliation(English) :TOTO LTD.

キーワード/Keyword:マテリアルサイエンス、膜加工・エッチング、AD 法、Y2O3、プラズマ耐性

1. 概要(Summary)

近年、半導体デバイスの高集積化を目的とした微細化 に伴い、ドライエッチング工程では、装置内部材からの発 塵(微小パーティクル)が深刻な生産課題となっている。こ れまで、弊社では低発塵性に優れるセラミックスコーティ ングを開発し、ドライエッチング装置内壁へのコーティング 材に展開してきた。近年、半導体デバイスの更なる低発 塵性の要求、プラズマ処理条件の多様化が進んでいる。 それに伴い、周辺部材へも低発塵性に優れるセラミックス コーティングが必要となってきている。そこで、産総研保有 技術であるハイブリットエアロゾルデポジション法(HAD 法)の応用を検討している。具体的には産総研と共同で 実施している NEDO のプロジェクト(SIP) にて推進してお り、そこで作製した HAD 膜の膜質について調査を行う為 に、化合物または酸化物ドライエッチング装置により、客 先で想定される各種エッチングプロセスを模擬した、プラ ズマ環境での腐食性評価を実施した。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

酸化膜ドライエッチング装置 (ICP-RIE by fluorine gas)

【実験方法】

 $AD_{Y_2O_3}$ 膜、 $HAD_{Y_2O_3}$ 膜を、酸化物ドライエッチング装置を用いて、ガス CHF_3 (100 sccm) $+O_2$ (10 sccm)、圧力 0.5 Pa、出力 ICP 1500 W、RIE 750 W の条件で 15、30、60 分の所定時間プラズマ環境で暴露した。プラズマ環境に暴露後のサンプルについて、プラズマ腐食速度の違いを評価した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

 $AD_{2}O_{3}$ 膜と $HAD_{2}O_{3}$ 膜のプラズマ腐食速度比について Fig. 1 に示す。AD 膜よりはやや劣るが AD 膜に近いプラズマ腐食速度を持つ HAD 膜を作製出来ていることがわかった。

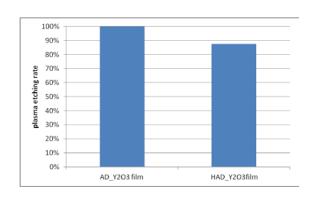


Fig. 1 Pictures of Plasma etching rate for AD Y₂O₃ films and HAD Y₂O₃ films.

4. その他・特記事項(Others)

・なし

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)なし

6. 関連特許(Patent)

なし